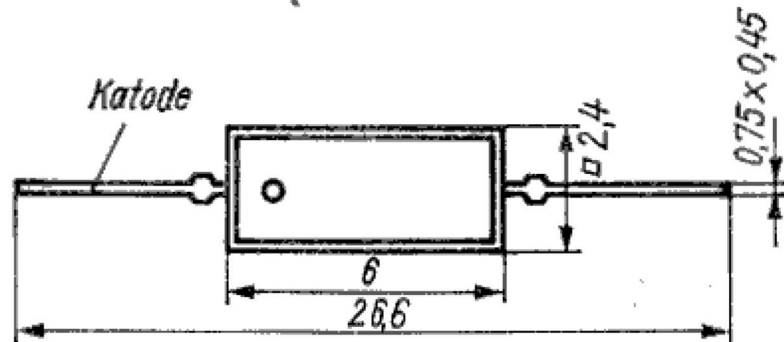


Silizium-Planar-Diode im Plastikgehäuse für Anwendungen in der Digital-, NF- und HF-Technik, vorzugsweise als mittelschneller Schalter in Logikschaltungen.



Grenzwerte (gültig bis ϑ_{jmax})

Sperrgleichspannung	U_R	25 V
Durchlaßgleichstrom	I_F	30 mA
Scheiteldurchlaßstrom	I_{FM}	60 mA
Sperrschichttemperatur	ϑ_j	+125 °C
Betriebstemperaturbereich	ϑ_a	-25 ... +100 °C
Lagerungstemperaturbereich	ϑ_{stg}	-55 ... +125 °C
Gesamtverlustleistg. bei $\vartheta_a = 25$ °C	P_{tot}	100 mW

Statische Kennwerte

Durchlaßspannung $I_F = 0,1$ mA, $\vartheta_a = 25$ °C	U_F	$\geq 0,50$ V
Durchlaßspannung $I_F = 3,0$ mA, $\vartheta_a = 25$ °C	U_F	$\leq 0,81$ V
Sperrstrom $U_R = 25$ V, $\vartheta_a = 25$ °C	I_R	≤ 40 nA
Sperrstrom $U_R = 25$ V, $\vartheta_a = 45$ °C	I_R	≤ 300 nA

Dynamische Kennwerte bei $\vartheta_a = 25$ °C

Kapazität $U_R = 0$ V, $f = 0,5$ MHz	C_o	≤ 8 pF
Sperrerrholungszeit beim Schalten von $I_F = 10$ mA auf $U_R = 6$ V gemessen bei $I_R = 1$ mA; $R_L = 50$ Ohm	t_{rr}	≤ 65 ns